

CMOSプロセス・フロー概要

群馬大学
松田順一

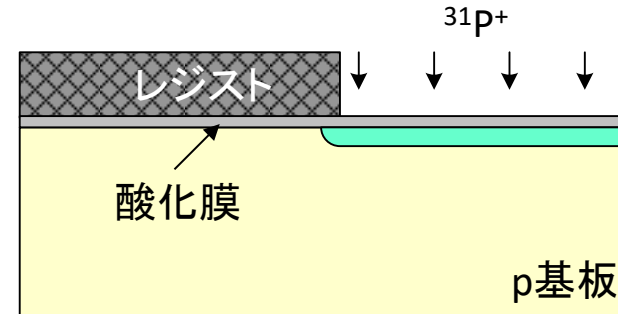
CMOSプロセス・フロー概要

- ウエル形成 (n-MOSFETとp-MOSFETの分離)
- 素子分離形成 (STI、LOCOS)
- MOSFET形成
 - ゲート酸化膜形成
 - ゲート電極形成
 - サイドウォール形成 (LDD構造)
 - ソース・ドレイン形成
- 配線形成
 - 層間膜形成、コンタクト (またはビア) 形成、メタル配線形成
- パッシベーション膜形成

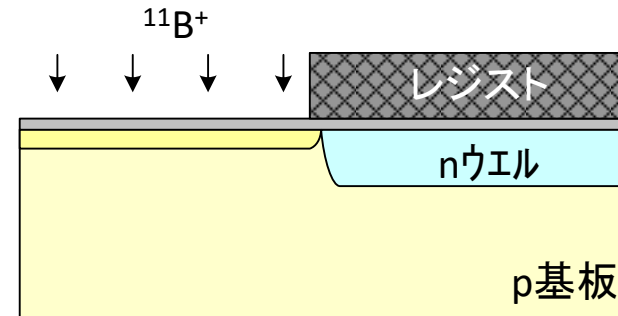
CMOSプロセス・フロー(1)

ウエル形成

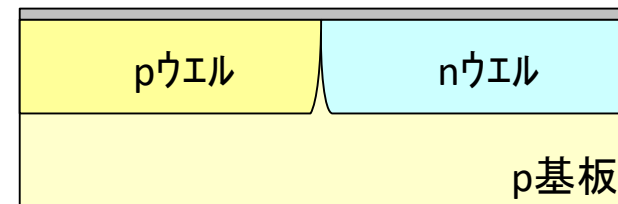
熱酸化
レジスト塗布
nウエル領域露光
 $^{31}\text{P}^+$ イオン注入
レジスト除去



レジスト塗布
pウエル領域露光
 $^{11}\text{B}^+$ イオン注入
レジスト除去



ウエル拡散

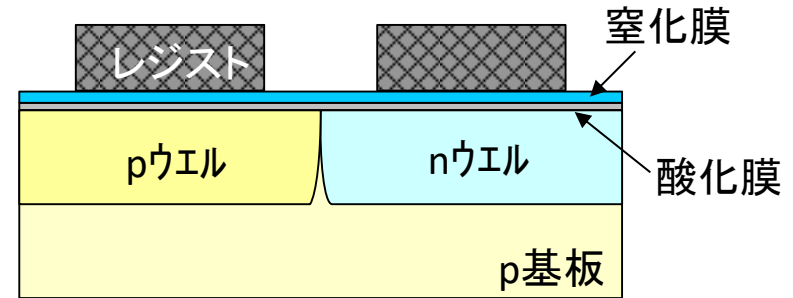


CMOSプロセス・フロー(2)

窒化膜デポジション

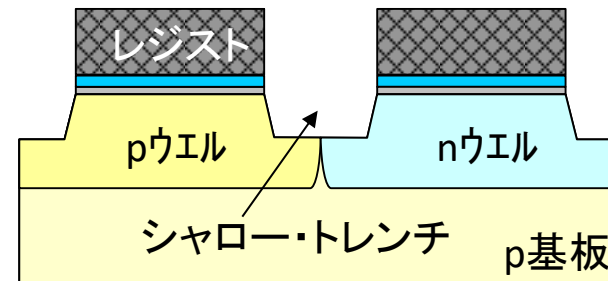
レジスト塗布

STI領域露光

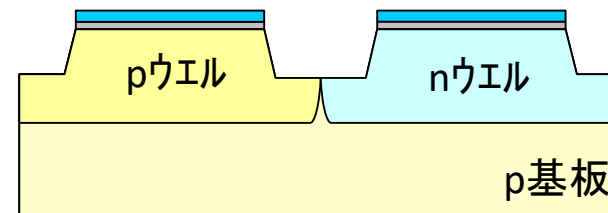


トレンチ形成
(素子分離)

トレンチ・エッチング



レジスト除去

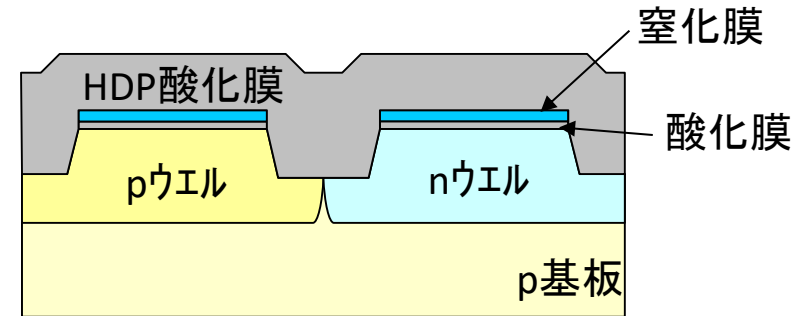


STI (Shallow Trench Isolation)

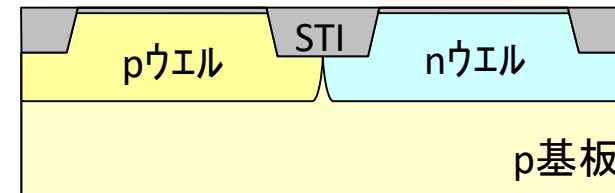
CMOSプロセス・フロー(3)

トレンチ埋め込み (素子分離)

熱酸化
HDP酸化膜デポジション



HDP酸化膜平坦化
(CMP)

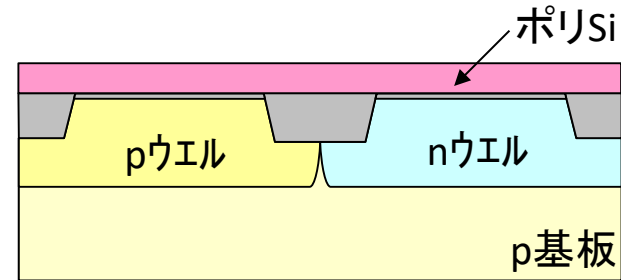


HDP (High Density Plasma)
CMP (Chemical Mechanical Polishing)

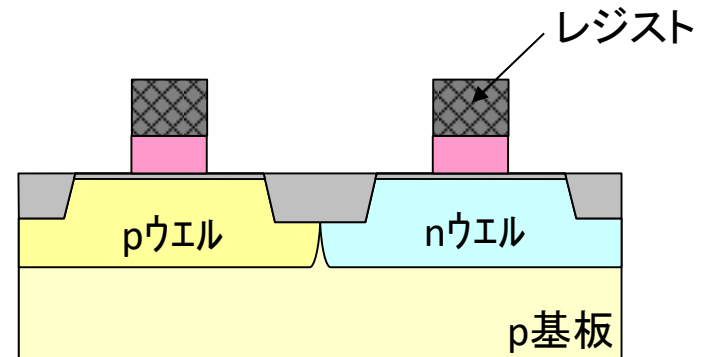
CMOSプロセス・フロー(4)

ゲート形成

酸化膜除去
ゲート酸化
閾値電圧用イオン注入
ポリSiデポジション



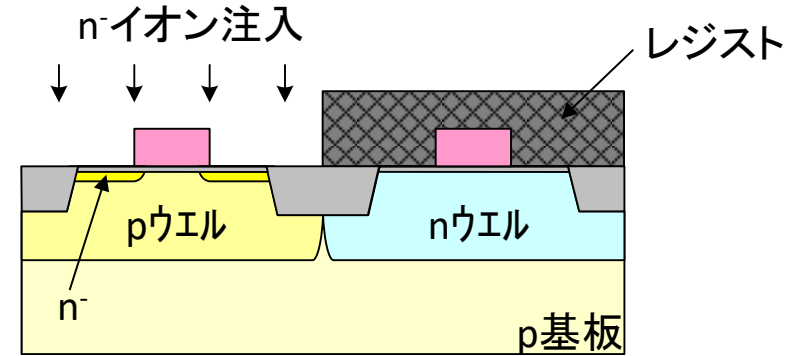
レジスト塗布
ゲート領域露光
ポリSiエッチング
(ゲート形成)
レジスト除去



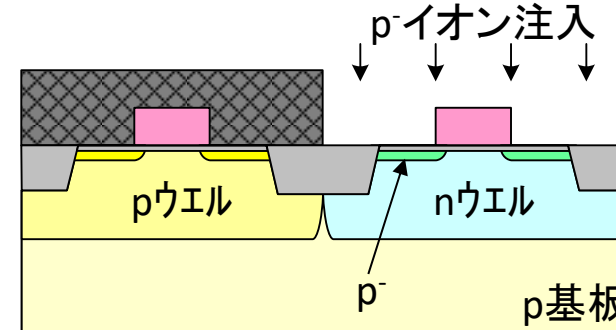
CMOSプロセス・フロー(5)

LDD形成 (ホット・キャリア耐性向上)

- レジスト塗布
- n-ch Tr領域露光
- n⁻形成用イオン注入
- レジスト除去



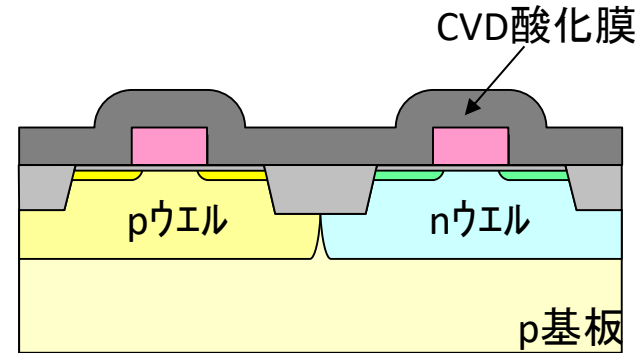
- レジスト塗布
- p-ch Tr領域露光
- p⁻イオン注入
- レジスト除去



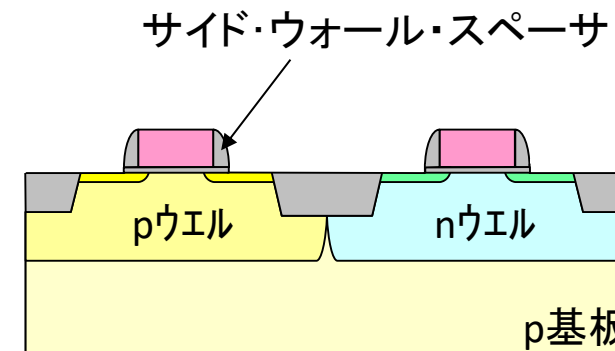
CMOSプロセス・フロー(6)

サイド・ウォール
スペーサ形成
(ホット・キャリア耐性向上)

CVD酸化膜デポジション



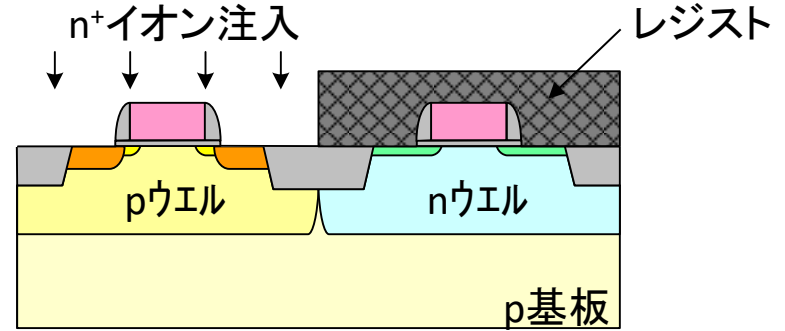
CVD酸化膜エッチング



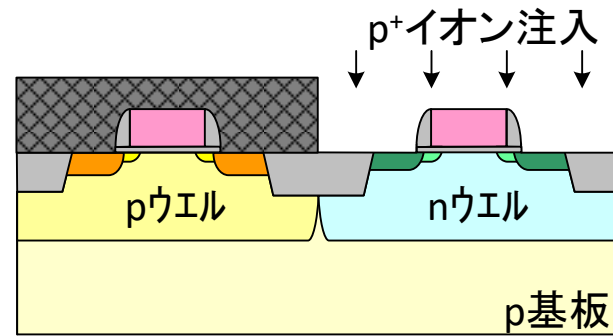
CMOSプロセス・フロー(7)

ソース・ドレイン形成

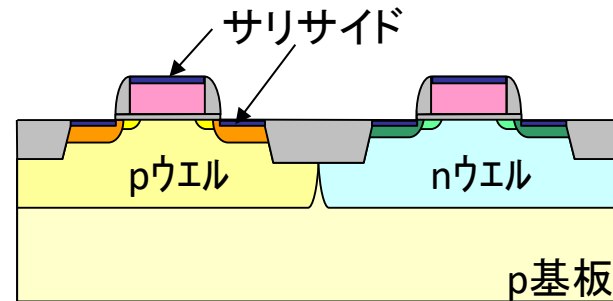
レジスト塗布
n-ch Tr領域露光
n⁺イオン注入
レジスト除去



レジスト塗布
p-ch Tr領域露光
p⁺イオン注入
レジスト除去



サリサイド形成
(WSi, TiSi, CoSi, NiSi)
ソース・ドレインの低抵抗化

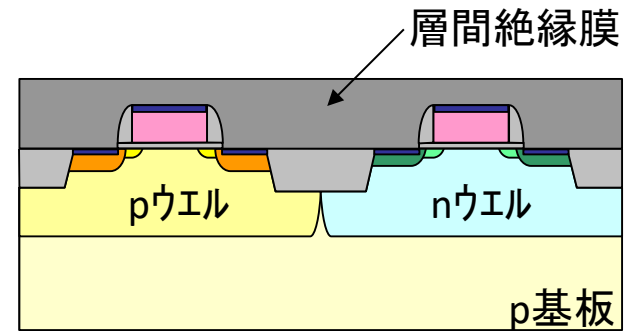


サリサイド (Self Aligned Silicide)

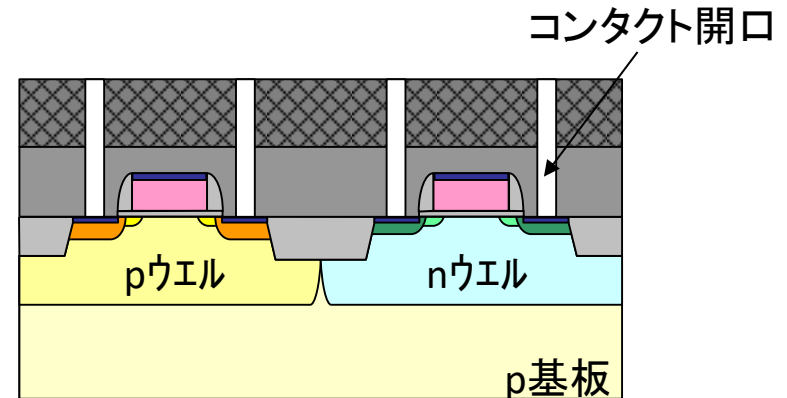
CMOSプロセス・フロー(8)

層間膜及び コンタクト形成

層間絶縁膜デポジション
層間絶縁膜平坦化



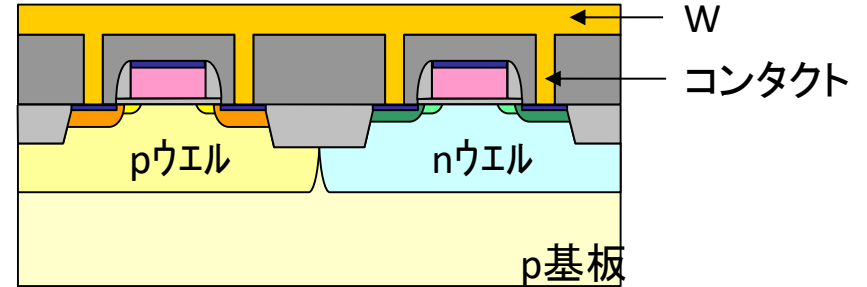
レジスト塗布
コンタクト領域露光
コンタクトエッチング
レジスト除去



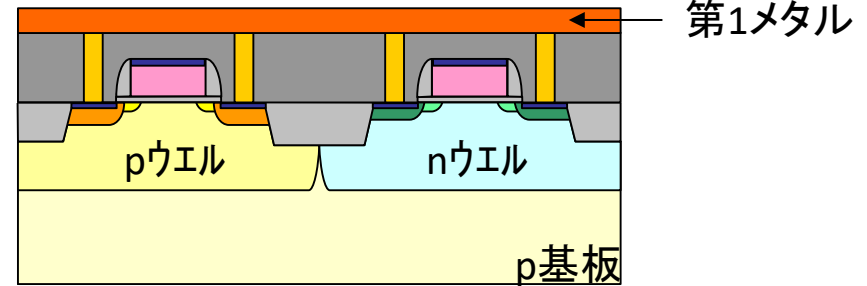
CMOSプロセス・フロー(9)

メタル配線形成

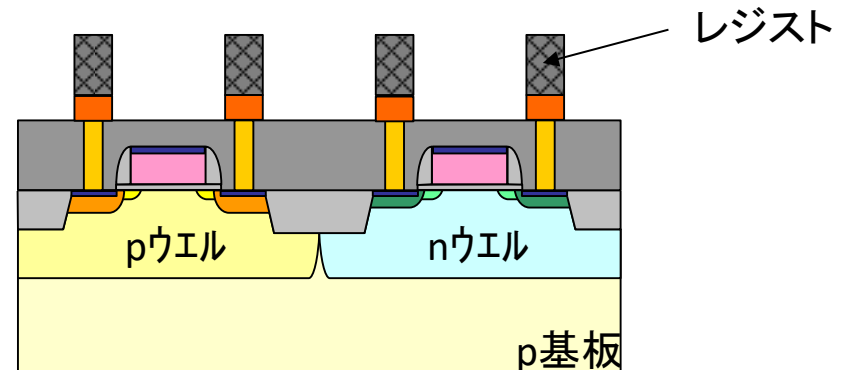
バリア・メタル・スパッタ
Wデポジション



Wエッチバック
バリア・メタル・スパッタ
第1メタル・スパッタ
バリア・メタル・ス
パッタ



レジスト塗布
配線領域露光
第1メタル・エッチング
レジスト除去



CMOSプロセス・フロー(10)

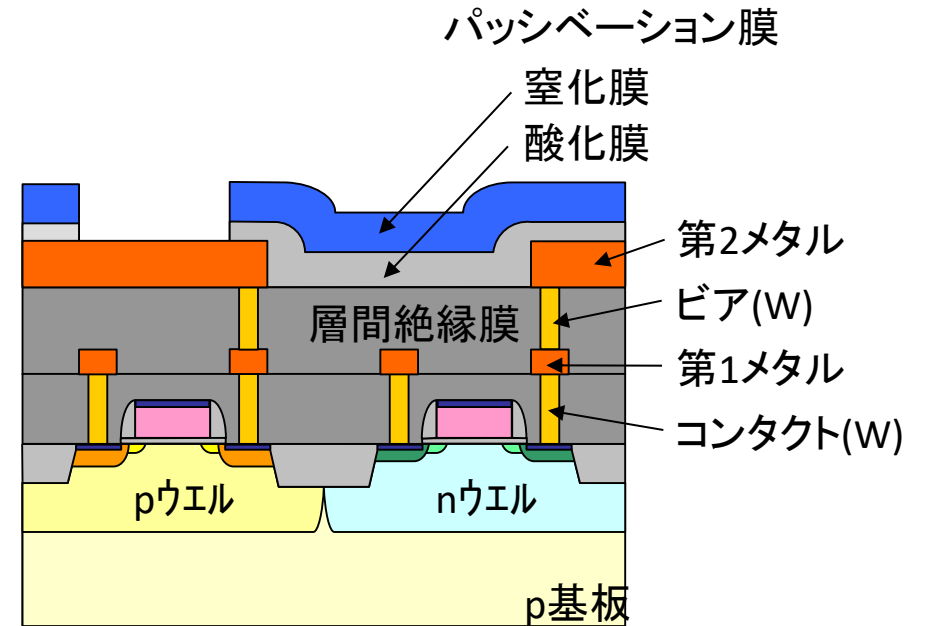
多層メタル配線 パッシベーション 膜形成

層間絶縁膜デポジション

ビア形成
(コンタクトと同様に形成)

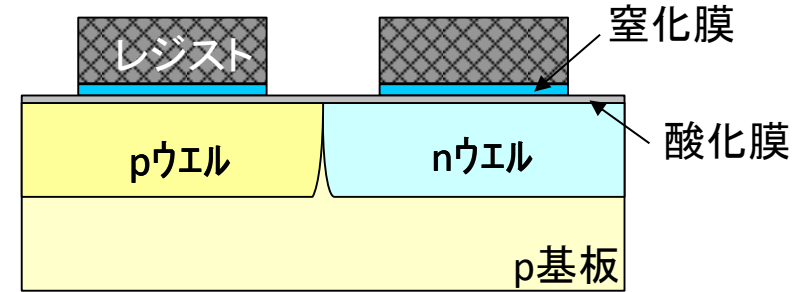
第2メタル配線形成
(第1メタルと同様に形成)

パッシベーション膜形成
(窒化膜+酸化膜)



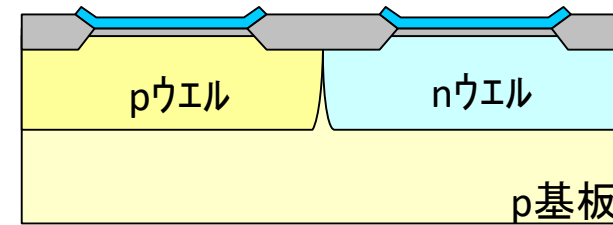
CMOSプロセス・フロー（補足1）

レジスト塗布
素子分離領域露光
窒化膜エッチング
レジスト除去

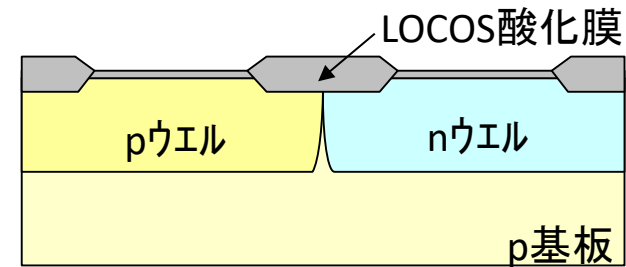


LOCOS形成 (素子分離)

LOCOS酸化



窒化膜エッチング



FinFET(補足2)

